# 高速スキャンCWレーザによるナノトレンチ構造の創製

東京工業大学·大学院総合理工学研究科 物質科学創造専攻

教授 吉本 護

(平成23年度 一般研究開発助成 AF-2011204)

**キーワード:** CWレーザ, 高速スキャン, ナノ周期構造

## 1. 緒言

ナノスケールで微細構造を作製する技術には、 走査型 プローブ顕微鏡や自己組織化現象を利用し, 原子・分子 を積み上げてナノ構造を構築していくボトムアップ的な 手法と、電子ビームリソグラフィーやドライエッチング を使ってマクロな材料からナノ構造を作り込んでゆくト ップダウン的な手法の二つがある<sup>1)</sup>.半導体加工技術の 飛躍的進歩により、マイクロマシーンなどの微細構造の 作製がされてきた. 直径100μm程度のモータなどの作製 はトップダウン式であるが、これらの微細加工技術は主 に小面積・平面を対象としており、被加工材料にも何か と制限がつけられることが多い.一方,自然界でも多く の微細構造が存在している. クジャクの羽の輝きやモル フォ蝶の鮮やかな色は、色素による発色ではなく、表面 の微細構造に起因する「構造色」である.また、蓮の葉 が水を弾くのも、微細構造による撥水性機能の発現であ ろ.

トップダウン的手法の一つであるレーザを使った切断 や穴あけ加工は,通常大気中で行われ、高度な清浄度は 要求されない.また大面積一括の微細加工技術として近 年注目されているナノインプリント法では、軟化特性な どの材料機能による制約も多いが<sup>2)</sup>、レーザ加工は,そ れら制約は少ない.レーザは加工プロセスとしての穴あ けや材料切断以外にも,製膜や熱的アニールの励起源と しても用いられている.レーザを使う製膜プロセスとし てはパルスレーザ蒸着法 (PLD法) があり,ナノレベル制 御の製膜を可能にしている<sup>3-5)</sup>.

我々はこれまでレーザによるシリコン半導体表面ア ニール処理の最適化実験を行っていた過程で偶然,レー ザアニールの光誘起による周期的ナノ構造の自己組織化 現象を見出した<sup>6)</sup>.その規則正しい「ナノかたち」から は、構造色による「着色」も観察された.構造色は可視 光に近いスケールの周期構造による光の干渉に起因し, 構造が壊れない限り「色落ち」しない.本研究での加工 技術は、フォトリソフラフィ等のトップダウン的なもの とは違い,ボトムアップ的な要素も加味されたナノ表面 プロセスである.そこで、本研究では2つの波長の違うCW (連続波)レーザを材料表面に高速スキャン(走査)し て照射することにより,自己組織化的にナノ周期構造を 表面形成させる技術を開発することを目的として,種々 の条件下でのレーザ照射実験を行った.

### 2. 実験方法

#### 2.1 レーザ照射システム

本研究で用いたレーザ照射システムは、スイッチング 素子等の裏面活性化のためのレーザアニール装置として 開発されたものを適用した.レーザアニールではレーザ の侵入する深さ程度でのアニール効果が期待される.ま た、その侵入長は用いるレーザの波長により変化する. 図1に2つの波長レーザスキャン装置の模式図を示した. 例えば、本システムで用いた近赤外線(797 nm)と可視 光(532 nm)の2波長のレーザのシリコン基板への侵入



図1. 高速走査型 2 波長 CW レーザ照射システム概略図. 2 つのレーザ(近赤外および可視光) が同軸でターゲット表面を毎分300mの速度で走 査する(最大走査速度;900 m/min.).

長は、それぞれ、1 μmと10 μm程度である.2つのレー ザの出力の調整により、アニール効果の中心の深さを制 御できる.ナノ周期構造を形成する本システムでは、試 料のスキャン速度は分速300mと非常に高速である。可視 光と近赤外レーザには、それぞれ、YV04レーザと半導体 レーザを用いた.表1に示すように,近赤外線レーザ出 力を一定として,可視光レーザ出力のみを変化させた. ターゲットには加速電圧200keVでリンを1x10<sup>13</sup>/cm<sup>2</sup> 注入 したシリコン基板を用いた.ターゲットへのレーザ照射 は空気中で行い、照射後のターゲット表面は原子間力顕 微鏡(AFM)と走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて観察した.

表 1. レーザ照射条件

レーザ	可視光	近赤外光
波長	532 nm	797 nm
スキャン速度	MAX. 900 m/min.	
照射エネルギー	$0 - 36 \text{ J/cm}^2$	$32 \text{ J/cm}^2$

#### 2.2 有限要素法によるレーザ照射時の熱伝導評価

レーザのスキャン照射に伴うターゲット基板の温度上 昇を見積るため、有限要素法によるシミュレーションを 行った.有限要素法には、三次元にも対応したオープン ソースで公開されているFreeFEM3Dを用いている.合計8 コアのXeonプロセッサー上で64ビット化してコンパイル した実行ファイルを用いている.用いた三次元熱伝導方 程式は、

$$\rho \, c_{\rm p}(T) \, \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \left( k(T) \nabla T \right) = Q(t)$$

で示される.ここで,ρはターゲット密度, ΦとTは温度 依存の比熱とターゲットの絶対温度である. *k*(T)は温度 依存熱伝導率であり, Qtターゲットに流入するエネルギ ーであり,2波長のレーザから供給される総熱量である. 時間依存の熱量Q(t)は次式で示すことができる.

$$Q(t) = (1 - R_{\rm g}) \alpha_{\rm g} I_{\rm g}(t) + (1 - R_{\rm ir}) \alpha_{\rm ir} I_{\rm ir}(t)$$

ここで、I(t)はスキャン速度に応じ移動するレーザ強度 分布であり、Rはレーザの反射率である.gとirはそれぞ れ可視光(Green)と近赤外光(InfraRed)レーザを示す.温 度依存比熱と熱伝導率は一般的な次式を用いた<sup>7)</sup>.

$$\begin{split} k(T) &= 0.235 + 4.45 \, e^{-T/247} \\ c_{\rm p} &= 0.81 + 1.3 \times 10^{-4} \, T - 1.26 \times 10^4 \, T^{-2} \end{split}$$

融点での潜熱Lf(latent heat of fusion)を考慮するため, 融点(Tm)を用いた潜熱を次式のようにガウシアン分布で 表した.

$$L_{\rm f} = \frac{1}{\sqrt{\pi} \,\delta T} exp\left(\frac{-(T-T_{\rm m})^{\,0.5}}{\delta T^{\,0.5}}\right)$$

ターゲットは長さ200 $\mu$ m,幅120 $\mu$ m,厚さ30 $\mu$ mとし,照 射側のみメッシュを細密(0.05 $\mu$ m)に取り裏面は粗くした.時間分解は1 $\mu$ 秒として計算を行った.

# 3. 結果及び考察

### 3.1 表面ナノ構造

2波長CWレーザスキャンにより形成したシリコン基板 上の表面ナノ周期構造を図2に示した.フェムト秒レー ザで作製されているナノ周期構造は繊維状構造<sup>8)</sup>である が、CWレーザによるナノ構造は凹凸を示し、平坦な底を 持つトレンチ構造となっている.フェムト秒レーザによ るナノ周期構造は、レーザの入射角により変化すること が知られているが、CWレーザによるナノ構造周期はレー



図2.2波長の CW レーザ高速スキャン照射に より自己組織的に形成されたナノ周期構造の SEM 像.約40µmのピッチ間隔で整然と配列し た線状トレンチパターンが観察される.



ザ出力で制御可能である.また、ナノ周期構造のトレ

図3. レーザ照射で形成されたナノ構造周期長 (□) とトレンチ高さ(○) の可視光レーザエ ネルギー密度に対する相関図. 可視光(523nm) レーザ密度に依存して,周期長が 500nm から 800nm の範囲で変化している.



図4.3次元有限要素法を用いて得られた,種々の パワーのCWレーザ照射時のSi基板表面での溶融領 域のシミュレーション結果.横軸は、レーザ照射点 の中心からの距離を示す.ナノ周期構造は溶融領域 内に形成された.

ンチの高さもレーザ出力により変化することが分かった. また図3には、ナノ構造周期長(□)とトレンチ高さ(○) の照射レーザエネルギー密度との相関を示した. 近赤外 光レーザの出力は一定として、可視光レーザの出力のみ を24から36 J/cm<sup>2</sup> まで変化させている. 図3からも分 かるように、レーザ出力による構造周期の変化は350 nm から800 nm程度であり、これは用いている2つのレーザ の波長である532 nmと797 nmに対応していると考えられ る.

次に有限要素法を用いてレーザ照射による基板温度の 変化を評価した.スキャン速度を毎分300mと一定にし, 実験と同じく可視光レーザのエネルギー出力を変えたシ ミュレーションにより,ターゲットの一部は溶融してい ることが分かった.

図4には可視光レーザの中心からの距離におけるレー ザ密度を示してある(破線).また、有限要素法により得 られたターゲットの溶ける範囲(melting area)を実線で 示してある.レーザ光源の出力が増えると溶融範囲も広 がっていることがわかる.更に太い実線領域では、実験 で得られたナノ周期構造の成長した範囲である.この図 から、溶融範囲の一部でナノ周期構造が成長しているこ とが分かる.更に時間依存温度上昇の解析により、ナノ 周期構造の成長には、溶融時間に5μ秒から6μ秒のしき い値があることが示唆された.

#### 3.2 ナノ周期構造による表面機能

本研究での2波長CWレーザスキャン法では、大気中で のラフな位置精度でも周期構造の形成が可能であった. 図5はシリコン基板上のナノ周期構造による着色(構造 色)の例であるが、シリコン試料板はパソコンの冷却ファ ンに貼付けて回しているだけの簡易なシステムである. 光源には白色光を用いているため、ナノ構造周期による 干渉で黄色から青、緑色と着色されている.冷却ファン の回転でもナノ周期構造が形成され,高さ方向での高い 精度も必要としないレーザ加工手法であることがわかっ た.



図5. CW レーザ照射により Si 基板上に形成された 周期的ナノトレンチ構造に由来する基板表面の構 造発色.レーザ照射時に基板回転させることによ り,同心円状のナノトレンチ構造が得られた.

次に、表面機能として撥水性の評価を行った. 接触角 と固体面と液滴のなす角であり、トマス・ヤングの式で 現される. 表面に凸凹があるとウェンゼルの式やカシー の式<sup>9、10)</sup> で近似できるとされている. シリコンは接触 角が90度以下であるので、微細構造により接触角は小さ くなることが予想される. 実際測定すると、シリコン基 板上に形成したナノ周期構造上での接触角はシリコン基 板に対して10度から20度小さい値になった.

## 4. 結論

本研究により、2つの異なる波長のCWレーザを同時照 射する「2波長CWレーザの高速スキャン」により、シリ コン基板表面上にナノ周期構造が形成されることを見出 した.本手法で形成されるナノ周期構造は、フェムト秒 で作製される繊維状周期構造とは異なり、平らな底を持 つナノトレンチ構造を示していた.また、その構造周期 は2つのレーザの波長域(赤外域の800nmから可視域の 500nm)で制御可能であることがわかった.今後の展開と して、紫外光レーザを用いれば、より幅広いナノ構造周 期の制御可能性が考えられ、さらにセラミックスなど 種々の材料にも拡張できることが期待される.

#### 謝辞 辞

本研究は公益財団法人天田財団の一般研究開発助成を

受けて実施したものであり,ここに感謝の意を表します. また、レーザ照射実験にあたり多大なご協力を頂いた神 奈川県産業技術センターの金子 智博士に謝意を表しま す.

## 参考文献

- 1)「第5版実験化学講座,第28巻 ナノテクノロジー の化学」、日本化学会編(丸善),165 (2005).
- 2)G. Tan, N. Inoue, T. Funabasama, M. Mita, N. Okuda, J. Mori, K. Koyama, S. Kaneko, M. Nakagawa, A. Matsuda and M. Yoshimoto: Appl. Phys. Exp., 7 (2014) 055202.
- S. Kaneko, K. Akiyama, Y. Shimizu, H. Yuasa, Y. Hirabayashi, S. Ohya, K. Saito, H. Funakubo, and M. Yoshimoto: J. Appl. Phys., 97 (2005)103904.

- 4) S. Kaneko, K. Akiyama, H. Funakubo, and M. Yoshimoto: Phys. Rev. B, 74 (2006) 054503.
- M. Yoshimoto, R. Yamauchi, D. Shiojiri, G. Tan, S. Kaneko and A. Matsuda: J. Ceram. Soc. Japan, 121 (2013) 1.
- S. Kaneko, T. Ito, K. Akiyama, Y. Hirabayashi,
  A. Matsuno, T. Nire, H. Funakubo, and M. Yoshimoto: Nanotechnology, 22 (2011) 175307.
- 7) S. de Unamuno and E. Fogarassy, Appl. Sur. Sci.,36 (1989) 1.
- 8) H. Chen, Huang, F. Zhao, R. Qi, R. Li, Z. Xu, X. He, J. Zhang and H. Kuroda, Phys. Rev. B, 72 (2005) 125429.
- 9) R. Wenzel, J. Phys. Collid. Chem., 53 (1949)1466.
- 1 0) A. Cassie, Faraday Soc., **3** (1948) 11.